



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0130029
(43) 공개일자 2014년11월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 21/027 (2006.01) *G03F 7/20* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0047894
(22) 출원일자 2014년04월22일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
JP-P-2013-095961 2013년04월30일 일본(JP)

(71) 출원인
캐논 가부시끼가이사
일본 도쿄도 오오따꾸 시모마루코 3조메 30방 2고
(72) 발명자
무라키 마사토
일본 도쿄도 오오따꾸 시모마루코 3조메 30방 2고
캐논 가부시끼가이사 내
히라타 요시히로
일본 도쿄도 오오따꾸 시모마루코 3조메 30방 2고
캐논 가부시끼가이사 내
(74) 대리인
장수길, 이중희

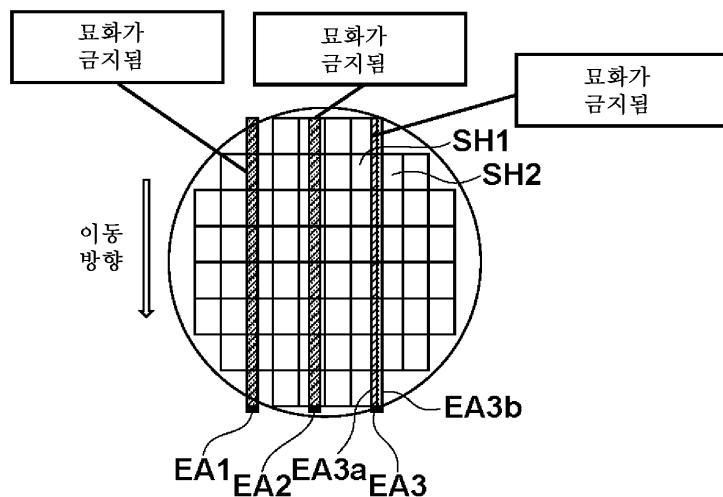
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **묘화 장치 및 물품의 제조 방법**

(57) 요 약

본 발명은, 하전 입자선으로 기판에 묘화를 행하는 묘화 장치이며, 상기 장치는, 스테이지의 이동과 복수의 하전 입자 광학계의 각각의 블랭킹 기능에 의해 행해지는 묘화의 제어를 행하도록 구성되는 컨트롤러를 포함하고, 컨트롤러는, 복수의 하전 입자 광학계 중 복수의 하전 입자선이 기판 상에 형성되고, 서로 인접하는 제1 영역 및 제2 영역에 도달하는 제1 하전 입자 광학계에 대해서, 제2 방향으로 스테이지를 이동시키면서, 제1 영역 및 제2 영역에서만 복수의 하전 입자선 중 제1 부분의 하전 입자선으로 묘화가 행해지도록 제어를 행하도록 구성되는 묘화 장치를 제공한다.

대 표 도 - 도4c



특허청구의 범위

청구항 1

하전 입자선으로 기판에 묘화를 행하는 묘화 장치이며,

제1 방향으로 배열된 복수의 하전 입자선을 개별적으로 블랭킹하는 블랭킹 기능을 각각 가지고, 상기 제1 방향으로 간격을 두고서 배치된 복수의 하전 입자 광학계와,

상기 기판을 보유 지지하여 이동할 수 있도록 구성되는 스테이지와,

상기 스테이지의 이동과 상기 복수의 하전 입자 광학계의 각각의 상기 블랭킹 기능에 의해 행해지는 묘화의 제어를 행하도록 구성되는 컨트롤러를 포함하고,

상기 컨트롤러는, 상기 복수의 하전 입자 광학계 중 상기 복수의 하전 입자선이, 상기 기판 상에 형성된 상기 제1 방향으로 서로 인접하는 제1 영역 및 제2 영역에 도달하는 제1 하전 입자 광학계에 대해서, 제2 방향으로 상기 스테이지를 이동시키면서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나에서만 상기 복수의 하전 입자선 중 제1 부분의 하전 입자선으로 묘화가 행해지도록 제어를 행하도록 구성되는 묘화 장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 컨트롤러는, 상기 제1 하전 입자 광학계에 대해서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나에서의 묘화 후에, 상기 제2 방향과 반대인 방향으로 상기 스테이지를 이동시키면서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 다른 하나에서만 상기 복수의 하전 입자선 중 제2 부분의 하전 입자선으로 묘화가 행해지도록 제어를 행하도록 구성되는 묘화 장치.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 제1 부분의 하전 입자선은, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 다른 하나에만 도달하는 하전 입자선을 제외한 하전 입자선이며, 상기 제2 부분의 하전 입자선은, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나에만 도달하는 하전 입자선을 제외한 하전 입자선인 묘화 장치.

청구항 4

제2항에 있어서, 상기 컨트롤러는, 상기 복수의 하전 입자 광학계 중 상기 복수의 하전 입자선이, 상기 기판 상에 형성된 복수의 영역 중 하나에만 도달하는 제2 하전 입자 광학계에 대해서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나, 또는 다른 하나의 묘화 동안에, 상기 복수의 영역 중 하나에서 상기 복수의 하전 입자선으로 묘화가 행해지도록 제어를 행하도록 구성되는 묘화 장치.

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 컨트롤러는, 상기 기판 상에 형성된 복수의 영역의 배치 및 상기 스테이지의 위치에 관한 정보에 기초하여, 상기 제1 하전 입자 광학계를 특정하도록 구성되는 묘화 장치.

청구항 6

제2항에 있어서, 상기 복수의 하전 입자 광학계의 각각은, 상기 기판 상의 위치를 변경하도록 상기 복수의 하전 입자선을 편향시키도록 구성되는 편향기를 포함하고,

상기 컨트롤러는, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나의 묘화 동안에, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나에 관한 대상 묘화 위치의 정보에 기초하여, 상기 편향기에 의해 상기 제1 부분의 하전 입자선이 편향되고, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 다른 하나의 묘화 동안에, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 다른 하나에 관한 대상 묘화 위치의 정보에 기초하여, 상기 편향기에 의해 상기 제2 부분의 하전 입자선이 편향되도록 제어를 행하도록 구성되는 묘화 장치.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 기판에 형성된 마크를 검출하도록 구성되는 검출기를 더 포함하고,

상기 컨트롤러는, 상기 검출기의 출력에 기초하여, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나 및 다른 하나의 각각에 대하여 상기 대상 묘화 위치의 정보를 얻도록 구성되는 묘화 장치.

청구항 8

제1항에 있어서, 상기 제1 방향과 상기 제2 방향은 서로 직교하는 묘화 장치.

청구항 9

제1항에 있어서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역의 각각은 샷 영역을 포함하는 묘화 장치.

청구항 10

물품의 제조 방법이며,

제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 기재된 묘화 장치를 이용하여 기판에 묘화를 행하는 단계와,

묘화가 행해진 상기 기판을 현상하는 단계와,

현상된 상기 기판을 가공하여 상기 물품을 제조하는 단계를 포함하는 물품의 제조 방법.

명세서

기술 분야

[0001]

본 발명은 묘화 장치 및 물품의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]

전자선 등의 하전 입자선을 이용한 묘화 장치는 기판의 각 샷 영역에 형성된 패턴(이하, "샷 패턴"이라고 칭함) 상에 중첩된 새로운 패턴을 묘화하는 오버레이 묘화를 행한다.

[0003]

오버레이 묘화에서는, 우선, 복수의 샷 패턴의 설계상의 어레이 좌표값에 근거해서 기판이 이동되고, 복수의 샷 패턴 중 일부가 기준 위치에 정렬되었을 때의 위치가 실측된다. 다음으로, 샷 패턴의 설계상의 어레이 좌표값과, 정렬할 실제의 어레이 좌표값이 소정의 오차를 포함하는 특유의 관계에 있다고 가정하여, 복수의 실측값과 정렬할 실제의 어레이 좌표값 간의 평균적인 편차가 최소로 되도록 오차 파라미터가 결정된다. 오차 파라미터 및 샷 패턴의 설계상의 어레이 좌표값에 기초하여, 샷 패턴의 실제의 어레이 좌표값이 얻어진다. 실제의 어레이 좌표값에 따라서 기판이 위치결정되고, 패턴이 묘화된다.

[0004]

이러한 오버레이 묘화에서는, 샷 패턴의 실제의 어레이 좌표값과 함께, 샷 패턴의 왜곡(예를 들면, 신장/수축 및 회전)도 측정된다. 샷 패턴의 왜곡은, 패턴을 형성할 때의 묘화 장치 등의 리소그래피 장치의 요인에 의해서, 또는, 패턴을 형성할 때의 열 처리에 기인하는 기판의 변형에 의해서 발생한다.

[0005]

도 5a는 기판 SB에 형성된 5(행)×5(열)의 샷 패턴의 어레이를 나타내는 도면이다. 실제의 샷 패턴 SP는 실선으로 표시되고, 설계상의 샷 패턴 SP'는 파선으로 표시된다. 도 5b는 기판 SB(실제의 샷 패턴 SP)에 대하여 복수의 하전 입자 광학계 CP1, CP2 및 CP3을 포함하는 묘화 장치에 의해 오버레이 묘화가 행해진 상태를 도시한다. 도 5b를 참조하면, 하전 입자 광학계 CP1 내지 CP3의 각각은 기판 SB에 대하여 5(행)×5(열)의 하전 입자선을 방출한다. 기판 SB를 보유 지지한 스테이지를 하전 입자 광학계 CP1, CP2 및 CP3에 대하여 상축으로 이동시키면, 하전 입자 광학계 CP1, CP2 및 CP3는 각각 스트라이프 형상의 영역 S1, S2 및 S3을 묘화한다(스트라이프 묘화). 이러한 스트라이프 묘화에서는, 하전 입자 광학계의 기판 이동 방향으로 배열된 하전 입자선에 의해 기판의 동일한 위치에 대해 다중 조사가 행해진다. 그러한 조사가 온/오프 제어되어, 기판 상의 하전 입자선의 조사량을 제어한다.

[0006]

각 하전 입자 광학계는 하전 입자선을 편향시키도록 구성되는 편향기를 포함한다. 이러한 편향기는 기판 상의 복수의 하전 입자선(에 의해 규정되는 묘화 영역)의 위치를 일괄 조정한다. 스트라이프 묘화에서는, 기판 상의 샷 패턴의 실제의 위치에 기초하여, 하전 입자 광학계의 묘화 영역의 위치를 편향기에 의해 조정하면서 샷 패턴에 새로운 패턴을 중첩시켜서 묘화한다.

[0007]

그러나, 샷 패턴의 치수에 따라, 도 5b에 도시된 하전 입자 광학계 CP3과 같이, 하전 입자 광학계의 묘화 영역이 기판 이동 방향에 직교하는 방향으로 인접하는 샷 패턴에 걸쳐질(즉, 인접하는 2개의 샷 패턴의 양쪽 모두에

위치할) 수도 있을 것이다. 이것은 이하와 같은 문제를 제기한다. 사실, 기판 상의 샷 패턴은 항상 설계상의 어레이 좌표를 따라 규칙적으로 배열되지는 않는다(즉, 샷 패턴의 위치가 어긋난다). 따라서, 샷 패턴에 대하여 묘화 영역의 위치를 조정(보정)하면서 묘화를 행할 필요가 있다. 그러나, 하전 입자 광학계의 묘화 영역이 기판 이동 방향에 직교하는 방향으로 인접하는 샷 패턴에 걸쳐진 경우에는, 하전 입자 광학계의 묘화 영역의 위치는 샷 패턴 중 하나에 대해서만 보정될 수 있다.

[0008] 이러한 문제를 해결하기 위해서, 일본 특허 출원 공개 제2004-172428호 공보에서는 복수의 하전 입자 광학계의 광축 간의 거리를 기계적으로 조정할 수 있는 묘화 장치를 제안한다.

[0009] 그러나, 이러한 종래 기술에서는, 복수의 하전 입자 광학계의 광축 간의 거리를 기계적으로 조정하는 정밀도가 충분하지 않아, 최근의 오버레이 묘화에서 요구되는 오버레이 정밀도를 충족시킬 수 없다.

선행기술문헌

특허문헌

[0010] (특허문헌 0001) 일본 특허 출원 공개 제2004-172428호 공보

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명은, 예를 들면, 복수의 하전 입자 광학계를 이용해서 기판에 묘화를 행할 때에 오버레이 정밀도의 관점에서 유리한 묘화 장치를 제공한다.

과제의 해결 수단

[0012] 본 발명의 일 측면에 따르면, 하전 입자선으로 기판에 묘화를 행하는 묘화 장치이며, 제1 방향으로 배열된 복수의 하전 입자선을 개별적으로 블랭킹하는 블랭킹 기능을 각각 가지고, 상기 제1 방향으로 간격을 두고서 배치된 복수의 하전 입자 광학계와, 상기 기판을 보유 지지하여 이동할 수 있도록 구성되는 스테이지와, 상기 스테이지의 이동과 상기 복수의 하전 입자 광학계의 각각의 상기 블랭킹 기능에 의해 행해지는 묘화의 제어를 행하도록 구성되는 컨트롤러를 포함하고, 상기 컨트롤러는, 상기 복수의 하전 입자 광학계 중 상기 복수의 하전 입자선이, 상기 기판 상에 형성된 상기 제1 방향으로 서로 인접하는 제1 영역 및 제2 영역에 도달하는 제1 하전 입자 광학계에 대해서, 제2 방향으로 상기 스테이지를 이동시키면서, 상기 제1 영역 및 상기 제2 영역 중 하나에서만 상기 복수의 하전 입자선 중 제1 부분의 하전 입자선으로 묘화가 행해지도록 상기 제어를 행하도록 구성되는 묘화 장치가 제공된다.

[0013] 본 발명의 추가적인 측면은 첨부된 도면을 참조하여 이하의 예시적인 실시 형태의 설명으로부터 명확해질 것이다.

도면의 간단한 설명

[0014] 도 1은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 묘화 장치의 구성을 도시하는 개략도.

도 2는 도 1에 도시된 묘화 장치의 하전 입자 광학계의 구성을 도시하는 개략도.

도 3a 내지 3c는 도 1에 도시된 묘화 장치의 묘화 처리를 설명하기 위한 도면.

도 4a 내지 4c는 도 1에 도시된 묘화 장치의 묘화 처리를 설명하기 위한 도면.

도 5a 및 5b는 오버레이 묘화에서의 스트라이프 묘화를 설명하기 위한 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0015] 이하, 본 발명의 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 설명할 것이다. 도면 전체에서, 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타내며, 그 반복되는 설명은 생략할 것이다.

[0016] 도 1은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 묘화 장치(1)의 구성을 도시하는 개략도이다. 묘화 장치(1)는 하전 입

자선에 의해 기판에 묘화를 행하는 리소그래피 장치이다. 본 실시 형태에서는, 복수의 하전 입자 광학계의 각각에 의해 방출되는 복수의 하전 입자선을 이용해서 기판에 패턴이 묘화된다. 하전 입자선은 전자선에 한정되지 않고, 예를 들면, 이온 범일 수도 있다.

[0017] 묘화 장치(1)는 복수의 하전 입자 광학계(본 실시 형태에서는, 3개의 하전 입자 광학계, 즉, 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C))와, 기판 스테이지(11)와, 위치 검출계(12)를 포함한다. 또한, 묘화 장치(1)는 블랭킹 제어 유닛(13)과, 처리 유닛(14)과, 편향기 제어 유닛(15)과, 위치 검출 처리 유닛(16)과, 스테이지 제어 유닛(17)과, 제1 기억 유닛(18)과, 데이터 변환 유닛(19)과, 제2 기억 유닛(20)과, 주 제어 유닛(21)을 포함한다.

[0018] 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)의 각각은 복수의 하전 입자선을 방출한다. 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)의 각각은 복수의 하전 입자선을 개별적으로 블랭킹하는 블랭킹 기능을 가진다.

[0019] 도 2는 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)로서 적용 가능한 하전 입자 광학계(100)의 구성을 도시하는 개략도이다. 하전 입자 광학계(100)는 하전 입자원(101)과, 콜리메이터 렌즈(102)와, 블랭킹 어퍼처 어레이(103)와, 정전형 렌즈(104)와, 자계형 렌즈(105)와, 대물 렌즈(106)와, 편향기(107)를 포함한다.

[0020] 하전 입자원(101)은, 예를 들면, LaB₆ 또는 BaO/W(디스펜서 캐소드)를 하전 입자선 방출 재료로서 포함하는 열전자형의 하전 입자원이다. 콜리메이터 렌즈(102)는 전계에 의해 하전 입자선을 수렴시키도록 구성되는 정전형 렌즈이다. 하전 입자원(101)에 의해 방출된 하전 입자선은 콜리메이터 렌즈(102)를 통하여 거의 평행한 하전 입자선으로 변한다.

[0021] 블랭킹 어퍼처 어레이(103)는 콜리메이터 렌즈(102)로부터의 거의 평행한 하전 입자선을 2차원적으로 배열된 어퍼처(도시 생략)에 의해 복수의 하전 입자선으로 분할한다. 블랭킹 어퍼처 어레이(103)는 복수의 하전 입자선을 개별적으로 구동가능한 정전형의 블랭킹 편향기(도시 생략)를 포함하고, 복수의 하전 입자선의 각각의 기판에의 조사와 비조사를 전환한다. 하전 입자선의 블랭킹(비조사)은 상술한 바와 같이 편향기를 포함하는 구성에 의해 행해질 수 있지만, 다른 공지의 구성에 의해 행해질 수도 있다.

[0022] 정전형 렌즈(104) 및 자계형 렌즈(105)는 블랭킹 어퍼처 어레이(103)의 복수의 어퍼처의 중간상을 함께 형성한다. 대물 렌즈(106)는 자계형 렌즈이며, 복수의 어퍼처의 중간상을 기판에 투영한다. 편향기(107)는 블랭킹 어퍼처 어레이(103)로부터의 복수의 하전 입자선을 일괄해서 소정의 방향으로 편향시키고, 복수의 하전 입자선에 의해 규정되는 묘화 영역 EA의 위치를 변경한다.

[0023] 다시 도 1을 참조하면, 기판 스테이지(11)는 기판(10)을 보유 지지해서 이동한다. 기판 스테이지(11)는, 예를 들면, 하전 입자 광학계(100)의 광축에 직교하는 X-Y 평면(수평면) 내에서 이동가능한 X-Y 스테이지와, 기판(10)을 보유 지지하도록(끌어당기도록) 구성되는 정전 쳉을 포함한다. 또한, 하전 입자선이 입사하는 개구 패턴을 포함하고, 하전 입자선의 위치를 검출하도록 구성되는 검출기가 기판 스테이지(11)에 배치된다.

[0024] 위치 검출계(검출 유닛)(12)는 기판(10) 위에 형성된 마크(예를 들면, 얼라인먼트 마크)에 레지스트(감광제)가 감광하지 않는 파장을 가지는 광을 조사하도록 구성되는 조사계와, 마크에 의해 정반사된 광의 상을 활성하도록 구성되는 활상 소자를 포함하고, 마크의 위치를 검출한다.

[0025] 블랭킹 제어 유닛(13)은 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)의 블랭킹 어퍼처 어레이(103)를 개별적으로 제어한다. 처리 유닛(14)은 버퍼 메모리 및 데이터 처리 회로를 포함하고, 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)의 제어 데이터를 생성한다.

[0026] 편향기 제어 유닛(15)은 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)의 편향기(107)를 개별적으로 제어한다. 위치 검출 처리 유닛(16)은 위치 검출계(12)로부터의 출력(검출 결과)에 기초하여, 샷 패턴의 실제의 좌표값(위치) 및 샷 패턴의 왜곡을 특정(산출)한다. 스테이지 제어 유닛(17)은 기판 스테이지(11)의 위치를 측정하도록 구성되는 레이저 간섭계(도시 생략)와 함께 기판 스테이지(11)의 위치결정을 제어한다.

[0027] 제1 기억 유닛(18)은 기판(10)에 묘화될 패턴에 대응하는 설계 그래픽 데이터를 기억하도록 구성되는 메모리이다. 데이터 변환 유닛(19)은 제1 기억 유닛(18)에 기억된 설계 그래픽 데이터를 묘화 장치(1)에 설정된 폭을

가지는 스트라이프로 분할하여, 묘화 처리를 용이하게 하기 위해 데이터를 중간 그래픽 데이터로 변환한다. 제2 기억 유닛(20)은 중간 그래픽 데이터를 기억하도록 구성되는 메모리이다.

[0028] 주 제어 유닛(21)은 CPU 및 메모리를 포함하고, 묘화 장치(1)의 전체(각 유닛)를 제어한다. 주 제어 유닛(21)은 기판(10)에 묘화될 패턴에 따라 중간 그래픽 데이터를 처리 유닛(14)(의 버퍼 메모리)에 전송하고, 상술한 묘화 장치(1)의 각 유닛을 통해서 묘화 장치(1)를 통괄적으로 제어한다. 본 실시 형태에서는, 블랭킹 제어 유닛(13), 처리 유닛(14), 편향기 제어 유닛(15), 위치 검출 처리 유닛(16), 스테이지 제어 유닛(17), 제1 기억 유닛(18), 데이터 변환 유닛(19) 및 제2 기억 유닛(20)이 개별적으로 구성된다. 그러나, 주 제어 유닛(21)이 이들 기능을 가질 수도 있다.

[0029] 도 3a 내지 3c는 묘화 장치(1)의 묘화 처리를 설명하기 위한 도면이다. 도 3a는 하전 입자 광학계(100)에 의해 방출되고, 기판 상의 묘화 영역 EA를 규정하는 복수의 하전 입자선의 어레이의 일례를 도시하는 도면이다. 본 실시 형태에서는, 복수의 하전 입자선은, 5(행)×20(열)의 하전 입자선을 포함한다. 행 피치는 열 피치보다 2배 더 크다. 바꾸어 말하면, 하전 입자 광학계(100)는 제1 방향(행 방향) 및 제1 방향에 직교하는 방향(열 방향)으로 배열된 복수의 하전 입자선을 방출한다. 기판 스테이지(11)의 이동 방향은, 도 3a에 화살표로 도시한 바와 같이, 지면의 상측으로부터 하측으로의 방향(제1 방향에 교차하는 제2 방향, 보다 구체적으로는, 제1 방향에 직교하는 방향)이다.

[0030] 이 경우에, 주 제어 유닛(21)은 기판 스테이지(11)를 연속적으로 이동시키면서, 기판 상의 동일한 위치에 열 방향으로 배열된 복수의 하전 입자선의 각각을 조사할 것인지의 여부를 제어하여 묘화를 행한다. 바꾸어 말하면, 주 제어 유닛(21)은 기판 스테이지(11)의 이동과 하전 입자 광학계(100)의 블랭킹 기능에 의한 묘화의 제어를 행한다. 기판 상의 위치 P1 내지 P6과, 기판 상의 위치 P1 내지 P6에서의 하전 입자선의 조사량(노광량) 간의 도 3b에 도시된 관계가 유지되도록, 도 3a에 도시된 대상 하전 입자선 어레이를 이용하여 기판에 묘화를 행할 경우를 가정한다. 모든 하전 입자선은 동일한 클럭에 의해 기판을 조사하고, 대상 하전 입자선 어레이의 행이 j, k, l, m 및 n으로 표시되고, 기판 스테이지(11)는 단위 클럭당 행 피치만큼 기판 스테이지를 이동시키는 속도로 열 방향으로 연속적으로 이동한다고 가정한다.

[0031] 이 경우, 대상 하전 입자선 어레이의 각 행 j 내지 n의 하전 입자선의 각각의 단위 클럭당 온/오프(즉, 기판에 하전 입자선을 조사할 것인지의 여부)를, 도 3c에 도시한 바와 같이 설정(제어)하면, 도 3b에 도시한 것과 같은 관계가 얻어진다. 도 3c를 참조하면, 점선은 기판 상의 위치 P1 내지 P6을 조사하는 행 j 내지 n의 하전 입자선의 온(정사각형) 및 오프(기호 없음)를 나타내는 신호에 대응한다. 이것은, 기판 스테이지(11)가 2개의 단위 클럭에 대응하는 대상 하전 입자선 어레이의 행 j 내지 n의 피치만큼 이동하기 때문이다. 도 3b에 도시하는 관계는 2개의 단위 클럭만큼 어긋난 열 j, k, l, m 및 n의 하전 입자선의 조사량을 가산하여 얻어진다. 열 방향으로 배열된 하전 입자선이 조사량의 계조를 제어하기 때문에, 상기 관계는 열 방향으로 배열된 모든 하전 입자선이 묘화를 종료하지 않으면 얻을 수 없다.

[0032] 도 4a 내지 4c를 참조하여, 묘화 장치(1)의 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)를 이용하여 기판의 샷 영역 SH에 묘화를 행할 경우에 대해서 설명한다. 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)의 각각은 제1 방향(행 방향) 및 제1 방향에 직교하는 방향(열 방향)으로 배열된 복수의 하전 입자선을 방출한다. 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)는 서로 간격을 가지고 이격되어 제1 방향으로 배치된다. 복수의 샷 영역 SH는 제1 방향을 따라 단단으로 배치된다. 기판 스테이지(11)는, 도 4a에 도시된 바와 같이, 지면의 하측으로, 즉, 제1 방향에 직교하는 방향으로 연속적으로 이동하는 것으로 가정한다.

[0033] 도 4a를 참조하면, EA1은 제1 하전 입자 광학계(100A)에 의해 방출되는 하전 입자선에 의해 규정되는 묘화 영역을 나타내고, EA2는 제2 하전 입자 광학계(100B)에 의해 방출되는 하전 입자선에 의해 규정되는 묘화 영역을 나타낸다. 마찬가지로, EA3은 제3 하전 입자 광학계(100C)에 의해 방출되는 하전 입자선에 의해 규정되는 묘화 영역을 나타낸다. 기판(10)을 보유 지지하는 기판 스테이지(11)가 이동하면, 제1 하전 입자 광학계(100A), 제2 하전 입자 광학계(100B) 및 제3 하전 입자 광학계(100C)는 대응하는 묘화 영역 EA1, EA2 및 EA3에 의해 스트라이프 형상의 영역을 묘화한다.

[0034] 도 4a에서, 묘화 영역 EA1, EA2 및 EA3는 기판 스테이지(11)의 이동 방향에 직교하는 방향으로 인접하는 2개의 샷 영역에 걸치지 않는다. 따라서, 묘화 영역 EA1, EA2 및 EA3의 전역에서 샷 영역 SH(에 형성된 샷 패턴)에 오버레이 묘화가 행해진다. 바꾸어 말하면, 1개의 샷 영역에만 도달하는 복수의 하전 입자선을 방출하는 하전 입자 광학계에 대해서는, 1개의 샷 영역에 복수의 하전 입자선을 조사해서 1개의 샷 영역에 묘화가 행해진다.

묘화 영역 EA1, EA2 및 EA3의 각각은, 기판 스테이지(11)의 이동 방향을 따른 샷 영역 간의 경계에서는 샷 영역(샷 패턴)의 실제의 위치에 기초하여 편향기(107)에 의해 하전 입자선을 제1 방향으로 편향시킴으로써 위치결정된다. 각 샷 영역의 실제의 위치(각 샷 영역에 관한 대상 묘화 위치의 정보)는 각 샷 영역에 형성된 얼라인먼트 마크를 위치 검출계(12)에 의해 검출하여 얻어진 결과(출력)에 근거해서 특정될 수 있다. 묘화 영역 EA1, EA2 및 EA3에 의해 스트라이프 형상의 영역을 묘화하면, 도 4b에 도시한 바와 같이, 기판 스테이지(11)를 제1 방향으로 스텝방식으로 이동시켜서 다음 묘화를 행한다.

[0035] 도 4b에서, 묘화 영역 EA1 및 EA2는 기판 스테이지(11)의 이동 방향에 직교하는 방향으로 인접하는 2개의 샷 영역에 걸쳐지지 않는다. 따라서, 상술한 바와 같이, 제1 하전 입자 광학계(100A) 및 제2 하전 입자 광학계(100B)에 대해서는, 묘화 영역 EA1 및 EA2의 전역에서 샷 영역 SH에 오버레이 묘화를 행할 수 있다. 한편, 묘화 영역 EA3은 기판 스테이지(11)의 이동 방향(제2 방향)에 직교하는 방향으로 인접하는 2개의 샷 영역, 보다 구체적으로는, 제1 샷 영역 SH1 및 제2 샷 영역 SH2에 걸쳐진다. 이와 같은 경우에는, 묘화 영역 EA3의 전역이 아니라, 그의 일부, 예를 들면, 제1 묘화 영역 EA3a의 제1 샷 영역 SH1에 오버레이 묘화를 행하고, 제2 묘화 영역 EA3b에서는 묘화를 행하지 않는다(즉, 제2 묘화 영역 EA3b에서의 묘화를 금지한다). 바꾸어 말하면, 제1 샷 영역 SH1 및 제2 샷 영역 SH2에 도달하는 복수의 하전 입자선을 방출하는 하전 입자 광학계에 대해서, 제1 샷 영역 SH1 및 제2 샷 영역 SH2 중 하나에 대해서만 묘화를 행한다. 보다 구체적으로는, 기판 스테이지(11)를 제2 방향으로 이동시키면서, 복수의 하전 입자선 중 일부, 즉, 기판 스테이지(11)를 제2 방향으로 이동시킬 때에 제1 샷 영역 SH1을 조사하는 하전 입자선의 조사를 제어한다. 이때, 제1 샷 영역(샷 패턴) SH1의 실제의 위치(대상 묘화 위치의 정보)에 기초하여, 편향기(107)에 의해 하전 입자선을 제1 방향으로 편향시킬 수도 있다. 제1 샷 영역 SH1의 실제의 위치는, 상술한 바와 같이, 제1 샷 영역 SH1에 형성된 얼라인먼트 마크를 위치 검출계(12)에 의해 검출하여 얻어진 결과(출력)에 근거해서 특정될 수 있다. 묘화 영역 EA1 및 EA2과, 제1 묘화 영역 EA3a에 의해 스트라이프 형상의 영역을 묘화하면, 도 4c에 도시한 바와 같이, 기판 스테이지(11)를 제1 방향으로 스텝방식으로 이동시키지 않고 다음 묘화를 행한다.

[0036] 도 4c에서, 묘화 영역 EA1 및 EA2에 의한 묘화는 종료되었기 때문에(도 4b), 묘화 영역 EA1 및 EA2에는 묘화를 행하지 않는다(즉, 묘화 영역 EA1 및 EA2에의 묘화가 금지된다). 한편, 묘화 영역 EA3에 대해서는, 묘화 영역 EA3의 일부, 즉, 제2 묘화 영역 EA3b의 제2 샷 영역 SH2에 오버레이 묘화를 행하고, 제1 묘화 영역 EA3a에서는 묘화를 행하지 않는다(즉, 제1 묘화 영역 EA3a에서의 묘화가 금지된다). 바꾸어 말하면, 제1 샷 영역 SH1 및 제2 샷 영역 SH2 중 다른 하나에만 묘화를 행한다. 보다 구체적으로는, 기판 스테이지(11)를 제2 방향과는 반대인 제3 방향으로 이동시키면서, 상술한 일부 하전 입자선을 제외한 하전 입자선, 즉, 기판 스테이지(11)를 제3 방향으로 이동시킬 때에 제2 샷 영역 SH2에 조사되는 하전 입자선의 조사를 제어한다. 이때, 제2 샷 영역(샷 패턴) SH2의 실제의 위치(대상 묘화 위치의 정보)에 기초하여, 편향기(107)에 의해 하전 입자선을 제1 방향으로 편향시킬 수도 있다. 제2 샷 영역 SH2의 실제의 위치는, 상술한 바와 같이, 제2 샷 영역 SH2에 형성된 얼라인먼트 마크를 위치 검출계(12)에 의해 검출하여 얻어진 결과(출력)에 근거해서 특정할 수 있다.

[0037] 전술한 바와 같이, 묘화 장치(1)는, 기판 상에 규정되는 묘화 영역이 기판 스테이지의 이동 방향에 직교하는 방향으로 인접하는 2개의 샷 영역에 걸쳐지는 경우에도, 높은 오버레이 정밀도로 각 샷 영역에 묘화를 행할 수 있다. 이것은, 묘화 장치(1)가, 하전 입자 광학계의 광축 간의 거리를 기계적으로 조정하지 않고서 인접하는 2개의 샷 영역에 대해 개별적으로 묘화를 행함으로써, 각 샷 영역과 하전 입자선 간의 높은 상대 위치결정 정밀도를 유지할 수 있기 때문이다. 기판 상에 규정되는 묘화 영역이 기판 스테이지의 이동 방향에 직교하는 방향으로 인접하는 2개의 샷 영역에 걸쳐지는 하전 입자 광학계는, 기판 상에 형성된 샷 영역의 어레이 및 기판 스테이지의 위치에 관한 정보에 근거해서 특정될 수 있다.

[0038] 본 실시 형태에서는, 1개의 샷 영역에만 도달하는 복수의 하전 입자선을 각각 방출하는 제1 하전 입자 광학계(100A) 및 제2 하전 입자 광학계(100B)에 대해서, 제1 샷 영역 SH1의 묘화 중에 상기 하나의 샷 영역에 묘화를 행한다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 제1 하전 입자 광학계(100A) 및 제2 하전 입자 광학계(100B)에 대해서는, 제2 샷 영역 SH2에 묘화를 행하는 동안에 상기 하나의 샷 영역에 묘화를 행할 수도 있다.

[0039] 본 실시 형태에서는, 기판 상의 하나의 샷 영역의 묘화를 단위로 설명하였다. 그러나, 묘화 장치(1)의 묘화의 단위는 샷 영역에 한정되지 않는다. 예를 들면, 기판 상의 침 영역을 묘화 단위로 이용할 수도 있다.

[0040] 묘화 장치(1)는 복수의 하전 입자 광학계를 이용해서 기판에 오버레이 묘화를 행하는 데에 유리하기 때문에, 예를 들면, 반도체 디바이스 등의 마이크로 디바이스, 또는 미세 구조를 가지는 소자 등의 물품을 제조하는 데에 적절하다. 물품의 제조 방법은, 묘화 장치(1)를 이용해서 위에 감광제가 도포된 기판에 잠상 패턴을 형성하는

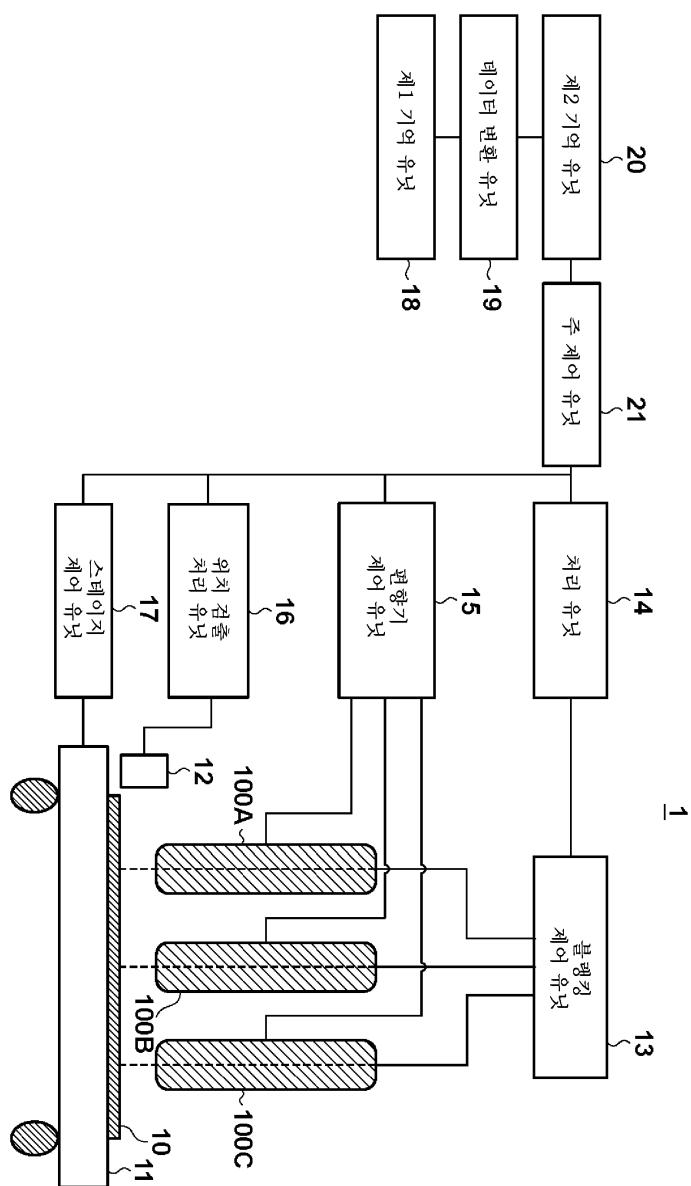
단계(기판에 묘화를 행하는 단계)와, 상기 단계에서 잠상 패턴이 형성된 기판을 현상하는 단계(묘화가 행해진 기판을 현상하는 단계)를 포함한다. 제조 방법은 다른 주지의 공정(예를 들면, 산화, 성막, 증착, 도핑, 평탄화, 에칭, 레지스트 박리, 다이싱, 본딩, 패키징)을 포함할 수도 있다. 본 실시 형태에 따른 물품의 제조 방법은, 종래의 방법에 비해, 물품의 성능, 품질, 생산성 및 생산 비용 중 하나 이상에 있어서 유리하다.

[0041]

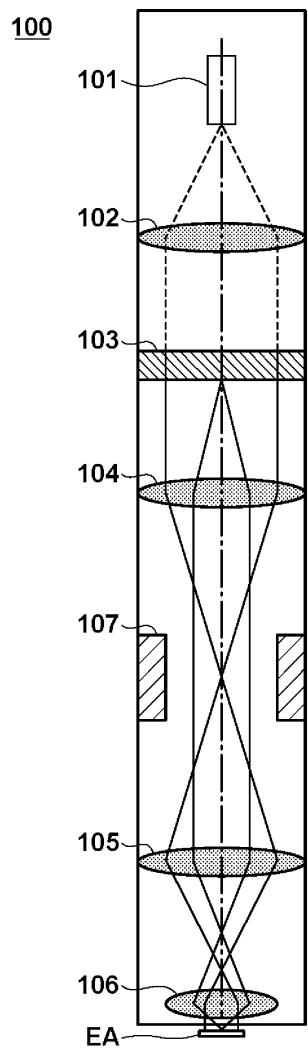
본 발명이 예시적인 실시 형태를 참조하여 설명되었지만, 본 발명이 개시된 예시적인 실시 형태에 한정되지 않음을 이해하여야 한다. 아래의 특허청구범위의 범위는 모든 변경과, 등가 구조 및 기능을 포함하도록 가장 넓은 해석과 일치하여야 한다.

도면

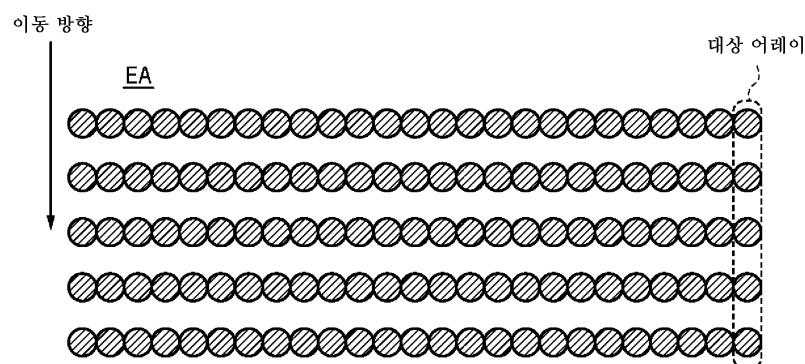
도면1



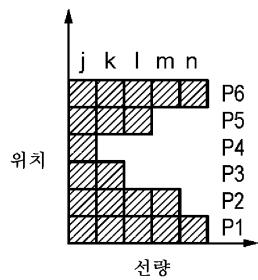
도면2



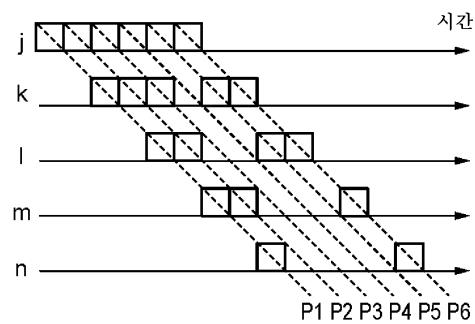
도면3a



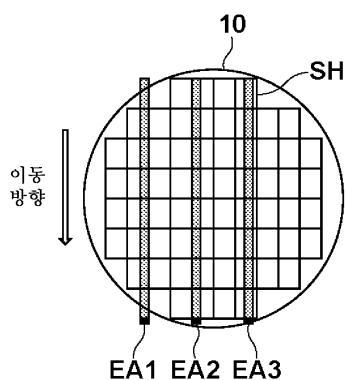
도면3b



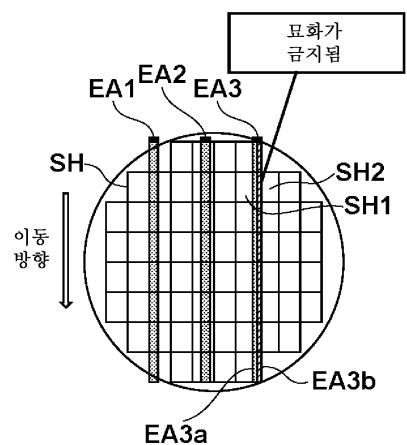
도면3c



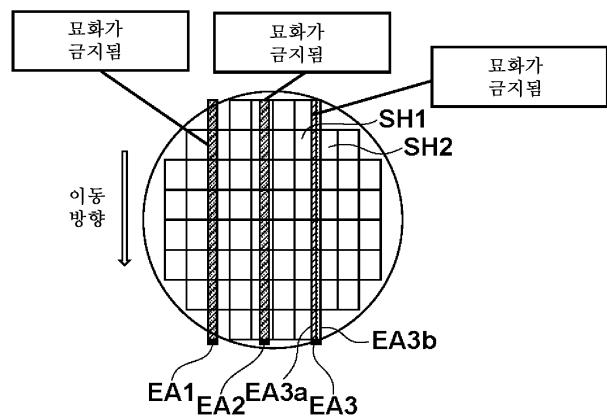
도면4a



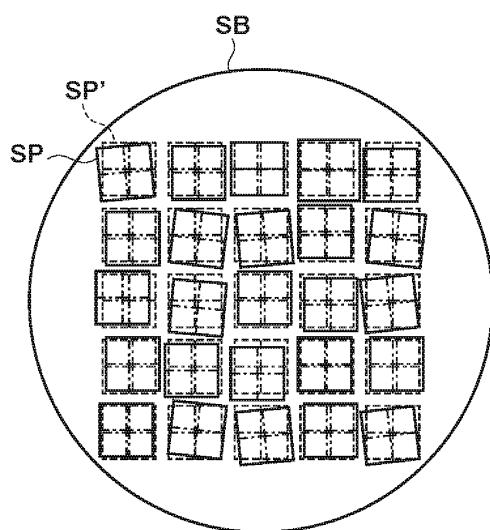
도면4b



도면4c



도면5a



도면5b

